

KOREAN PATENT ABSTRACTS

(11)Publication

100273981 B1

number:

(43)Date of publication of application:

06.09.2000

(21)Application number: 1019930023495

(71)Applicant:

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

(22)Date of filing:

06.11.1993

(72)Inventor:

AHN, SANG HO

(51)Int. CI

H01L 23/48

(54) PACKAGE FOR SEMICONDUCTOR DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: A package for semiconductor device is provided to increase the number of chip pad by mounting a semiconductor chip of a diamond shape on a lead frame of a diamond shape,

CONSTITUTION: A lead frame(20) has a rectangular shape. A semiconductor chip(23) has the same shape as the lead frame(20) and the same Interior angle of the lead frame(20). A multitude of chip pad is arranged on the semiconductor chip(23). The lead frame(20) is formed with a die pad(22) of a diamond shape. The semiconductor chip(23) of a diamond shape is mounted on the lead frame(20). A multitude of chip pad and a multitude of inner lead are bonded on the pad of the semiconductor chip(23) by a wire.

COPYRIGHT 2001 KIPO

Legal Status Date of final disposal of an application (20000831) Patent registration number (1002739810000) Date of registration (20000906)

등록특허번호 제0273981호(2000,12.15) 1부.

MARGER JOHNSON

[첨부그림 1]

10-0273981

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 동독특허공보(B1)

(51) Int. Cl. ¹ HDIL 23/48		(45) 공고일자 (11) 등록번호 (24) 등록일자	2000년 12월 15일 10-0273991 2000년 09월 06일	
(21) 출원번호	10-1993-0023495	(65) 공개번호	5 1995-0015733	
(22) 출원일자	1993년11월 06일	(43) 공개임자	1995년06월 17일	
(73) 특허권자	삼성건자주식회사 은 종용			
(72) 발명자	경기도 수원시 잘달구 때단3등 416 안상호			
, , ,	총청남도 천안시 청수룡 국동이파트 204동 506호			
(74) 대리인	898 SEA 848 HERITT 1948 WIT			
NAT: SAB.				

(54) 반도체 장치용 패키지

RY

이 발명을 반도체 정치용 패키지의 리드 프레임에 관한 것으로써, 참 패드간의 간격 및 리드 프레임 인너 리드 간격의 한계치로 인하여 주어진 동안한 반도체 협 면적을 갖는 반도체 참상에 보다 많은 참표도를 부대하는데 한계성을 극복하기 위하여, 반도체 리드 프레임의 다이패드를 마통고 형태로 형성하여 배치하 고, 이 반도체 검도 프레임상에 동입한 내각을 갖는 마음모 형태의 반도체 검을 실장하려고 상기 반도체 참의 패드상에 반도체 리드 프레임의 내각만큼 늘어난 다수개의 참 패드와 미와 대용되어 형성된 다수개 의 인너리드가 있어며 본당되도록 구성 되었다. 따라서 소장의 내각을 갖는 마음모 형태의 리드 프레임상 에 미와 대응되는 마음모형 반도체 점을 실장함으로써 동일한 내각도체 참 현재에서 참 패드수를 빼가시 켜 인너리드 패턴을 보다 다양하게 구성시킬 수 있는 반도체 장치용 패키지에 적용된다.

045

<u> 51</u>

gaa

[발암의 명칭]

반도체 잠치용 피키지

[도면의 간단한 성명]

제1도는 종래의 반도체 장치용 패키지의 임실시예를 나타내는 평면도,

제2도는 중래의 정시각형 반도체 칩의 레이-아웃음 나타내는 평면도,

제3도는 중래의 반도체 장치용 패키지의 일실시에를 나타내는 요부 확대도,

제4도는 이 발명에 따른 반도체 장치용 패키지의 임실시예를 나타내는 평면도,

제5도는 더 발명에 따른 마를모형 반도체 협의 레이-아웃을 나타내는 평면도.

제6도는 이 방영에 따른 마를모형 리드 프레임의 원실시예를 나타내는 평면도,

제7또는 이 방향에 따른 마음도 형태의 참 내각에 따른 참패도의 작용예를 나타내는 그래프이다.

[발명의 상세한 설명]

이 발명은 반도체 장치용 패키지의 리드 프레임에 판한 것으로써, 더욱 상세하게는 소청의 내각을 갖는 마음모 형태의 리드 프레임암에 미안 대용되는 마음모형 반도체 힘을 실장함으로써 정시각형 또는 직사각 형 반도체 결과 동일한 반도체 집 면적내에서 힘 패드수를 배기시켜 인너리드 패턴을 보다 다양하게 구성 시킬 수 있는 반도체 장치용 패키지에 관한 것이다.

최근들어 반도체 패키지 분야에 있어서 반도체 소자 자체에 다기능화를 부여하고, 반도체 점의 대형화 및 리트수의 다면화 추세에 따라 반도체 중체의 제조 기술뿐만에나라 그 조립기술의 고도화가 관명한이 요구 되어 왔다. 따라서 하나의 반도체 측에 여러가지의 기능을 부여하다 보니 이에 대용되는 참 제도수도 중 기하고, 그 사이즈도 중대되어 가고 있는 추세에 있다.

제 1 도는 중에의 반도체 장치용 때가지의 일실시예를 나타내는 평면도이다.

제 1 도를 참조하면, 상기 반도체 장치용 마키지는 정사각형 형태의 반도체 라드 프레임(10)과, 상기 반

7-1

[첨부그림 2]

10-0273981

도체 리드 프레임(10)의 외곽에서 연장되어 서포트바(11)에 의해 지지되며 있는 다이피드(12)와, 상기 다 미페드(12)상에 실장되어 있으며 이 반도체 리드 프레임(10)과 동말한 내각을 갖는 동말한 형태의 반도체 참(13)으로 구성되어 있다.

여기서, 마설광 부호 (A는 반도체 리드 프레임(10)의 사방으로 배열 형성되는 인너리드 영역을 나타내며, L은 한번의 리드 프레임의 길이를 각각 나타낸다.

제 2 도는 종래의 정시각형 반도체 첩의 레미-아웃 평면도를 나타내고 있다.

여기서 상기 정사각형 반도체 칩(13)은 반도체 첩 패드(14)와 패드(14) 시미의 피치(p)와 모서라에서의 첩 패드(14)의 마격거리(a)에 따라 인너리드물의 배치 간격이 정해지며 립미(L)만큼의 범위내에서 인너리 드달이 배치된다.

이와 같이 구청된 중래의 반도체 장치용 패키지는 제 3 도익 요부 확대도를 참조하면, 제 2 도에 도시된 정시각형 반도체 창(13)여 다이패드(12)상에 그대로 실장되고, 소청의 리드 짓치(Pt)로 배열 형성된 인너리드(16)와 참 패드(14)가 와이머(15)에 의해 견기적으로 연결된다.

그러나, 상기와 같은 중래의 반도체 장치용 패키지를 그래도 적용한 상태에서 리드 프레임의 레이-아웃 곡물 최대로 물인다 하여도 조립공정을 와이어 본딩때문에 칩 패드간의 간격을 한계치 이하면 몸을 수 없 다는 단점이 있다. 또한 반도체 칩에 아무리 철 패드를 많이 부여하여도 리드 프레임의 엔너리드 짓치 한 계때문에 리드 프레임 제작에 커다란 여러움이 발생되고 있다.

즉, 용래의 반도체 청의 협상은 정사각형 또는 직사각형 형태를 취하는데 이 형태의 침을 입반 반도체 장 치용 회키자에 많재 시키기 위해서는 보통 라드 프레임 배드현상을 참 협상과 동말하게 구성한다. 또한 상기 반도체 협상의 패드는 주변에 배열 협성된 인네리드를과 전기적으로 연결하기 위하여 디자인들에 적 합하게 적발히 배열 형성되는데, 상기 반도체 협과 리드 프레임과인 전기적 연결을 위해 라드 프레임 인 네리드 패턴도 와이며 본임에 적합하게 배열 형성되어야 하는 것이다.

마라서 칩 패드간의 간격 및 리드 프레임 인내리드 간격의 한계치로 연하며 주어진 동일한 반도체 칩 면 적을 갖는 반도체 칩상에 보다 많은 칩 패드를 부여하는데 한계가 있으며, 반대로 반도체 칩상에 아무리 많은 칩 패드를 부여해도 리드 프레임 인내리드 간격의 한계 때문에 조립이 됩기능해 진다는 단점이 있다.

미글 보다 구체적으로 설명하면, 정사각형 형태의 반도체 컵을 예측증이 a값을 40cc라고 가정하고 반도체 컵 패드의 파치(P)를 120cc라 하면, 상기 반도체 컵(13)에 최대로 적용시킬 수 있는 컵 패드수(N)는 다음 제 1 석과 같다.

$$N = 1 \times \frac{L-2a}{p} \qquad \dots \tag{1}$$

즉, 반도체 철 싸이즈가 5.0 ×5.0m인 경우 반도체 칩의 페드수(N=104)개 까지 부대할 수 있다.

마찬가지로 상기 반도체 첩을 적용시키기 위하며 리드 프레임 때문을 미상적으로 적용할 수 있도록 상기 참과 동려한 형태면 정사각형 형태를 취한다면 리드 프레임의 인너리드 첫치의 제작 한계에 따른 디자인 통에 상당한 제약을 받게된다.

결과적으로 중래의 반도체 중치용 패키지는 반도체 웹 싸여즈가 5.0 ×5.0m인 경우 여기에 수용될 수 있는 반도체 협의 패드는 16세개 이상은 불가능하고 또한 리드 프레임 패드 형성을 정사각형 또는 직사각형 얼마를 갖는다면 리도 프레임의 인너리도 디자인 제작과 미골 수용할 수 있는 인너리도수도 상당한 제약을 받게 된다.

따라서 이 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로 이 발명의 목적은, 정시각형 또는 적시각 형 반도체 취과 동일한 반도체 침 면적에 보다 많은 반도체 철의 피드를 부대하고, 리드 프레임도 여와 마찬가지로 디자인의 원활성을 부대하여 보다 많은 인더리드를 부여하여 다기능의 반도체 참과 이에 적용 되는 반도체 정치용 패키지를 제공하는데 있다.

작기한 목적을 달성하기 위한 이 말령에 따른 반도체 장치용 패키지의 목장은, 정시각형 형태의 반도체 리드 프레임과 이 반도체 리트 프레임과 동일한 내각을 갖는 동일한 형태의 반도체 참과, 상기 반도제 참 상에 배열 현성된 다숙자의 참 페드와, 상기 다수처의 참 페드와 와이어 분당되는 다수재의 인너리드를 구비하는 반도체 장치용 패키지에 있어서, 상기 반도체 컨트 프레임은 마류로 형태로 형성되며 해치되고, 상기 반도체 리드 프레임산에 동말한 내각을 갖는 마음모 형태의 반도체 참이 설정되며, 상기 반도체 참 의 파트상에 반도체 레임드 프레임의 내각 만을 늘어난 다수재와 참 제도와 이와 대용되어 형성된 다수제의 앤너리드가 와이어 본당되어 형성되는 점에 있다.

이하, 이 발명에 따른 반도체 장치용 때키지의 하나의 실시예를 침부된 도면을 참조하며 상세히 설명한다.

제 4 도는 이 발명에 따른 반도체 장치용 패키지의 양실시에를 나타내는 평면도이다.

제 4 도움 참조하면 이 발명에 있어서, 제 1 도의 종래의 정사각형 또는 직사각형 형태의 반도체 칩 및 리드 프레임의 다이페드 형상과 다른점은 상기 반도체 첩을 마음모 형태의 첩으로 구성시키고 리드 프래 [첨부그림 3]

10-0273981

임의 패드도 마음모 형태를 취하는 점에 있다.

상기 반도체 장치용 때키지는 본당에 적합하도록 배열할 수 있는 반도체 리드 프레임(20)의 인너리드 패 탑과, 상기 반도체 리드 프레임(20)의 외곽에서 연장되며 서포트 바(21)에 의해 저지되어 있는 마음모 형 태의 다마파드(22)와, 상기 다마패트(22)상에 실장되어 있으며 이 반도체 리드 프레임(20)과 동일한 내각 을 갖는 동일한 험태의 반도체 참(27)으로 구성되어 있다.

여기서, 미설명 부호 1A'는 반도체 리드 프레임(20)의 사방으로 배양 형성되는 인너리드 영역을 나타내며, L'는 한변의 리드 프레임의 길이를 각각 나타낸다.

제 5 도는 이 발명에 따른 마릅모형 반도체 취의 레미-아웃의 평면도를 나타내고 있다.

여기서 상기 마음모형 반도체 칩(23)은 반도체 칩 피드(24)와 페드(24) 사미의 피치(p)와 모서리에서의 칩 페드(24)의 미격거리(a)에 따라 인너리드룹의 배치 강격이 정해졌다. 이때 상기 반도체 칩(23)은 모서 리 부분에서 교각을 갖도록 협성되어 있다.

이와 많이 구성된 이 발명에 따른 반도체 장치용 패키지는 제 6 도에 도시된 바와 같이 마음모형 반도체 같이 다이패드(22)상에 그대로 실장되고, 소정의 α '각을 갖는 다이패드(22) 형상을 하고 있다. 따라서 반도체 참 및 리드 프레임 패드의 레이-아웃을 삼현하기 위해서는 그 내각(α , α ')이 50° 이상으 를 다마하면서

즉, 반도체 협의 내각(a)를 80°로 취했음때와 정사각형 형태의 반도체철과의 처이를 설명하면, 정사각 형 형태의 반도체 협 새비스가 25m(5.D ×5.0m)라고 할때, 정사각형 형태의 반도체 결과 동일한 마음모 형태의 반도체 집에 적용시킬 수 있는 칩 패드의 수는 176개까지 가능하다(청사각형 형태일 때는 164개). 이와 같은 마름모 내각에 따라 기대될 수 있는 효과을 다음의 표 1에 나타내었다.

[# 1]

단위: : ##

a 95年	ş, ·	L'(L=5)	K
50*	1.1425L	5.712	187i/A
80°	1.0476L	ā.373	17HE4
70°	1.0318L	5.158	15984
80°	1.0077L	5.038	185EA

이때, 상기와 같은 표 1을 만족시키기 위한 조건은 e=40ps, p=120ps이고 *'=="1/sin++ x t 로 된다. 이와 같이 표 1에 의해 열어짐 수 있는 효과는 제 7 도에 LIEF내었다.

제 7 도债 참조하면, 50° 근처의 마름모 내각(α)범위내에서 참 패드의 수가 대략 187개로 되며, 각도가 적어질수목 더 많은 수로 참 패드가 증대될을 앞수 있다.

여기사 마음모 형태의 반도체 철을 적용하기 위하여 마음모 형태의 리드 프레일 팬드를 구성시켰는데, 그 효과는 마음모 형태의 철에서 나타난 효과와 동일하게 청사각형 또는 적시국형 리드 프레잉 패드와 동일 한 명착을 갖는 마음도 형태의 리드 프레잉 패드는 외국 물레의 힘이가 크게되므로 인너리드 매턴의 디자 인 영역에 넘어져 보다 많은 인너라드를 삽입할 수 있다.

예름하면, 정시각없 형태의 다이테드를 갖는 리드 프레임에서 인너리도 멋치가 0.2mg에 때 인너리도가 배 임할 수 있는 수는 제 4 도에 도시된 바와 라이 6각이 크면 종수쪽 인너리도가 배명될 수 있는 수는 중 기하지만, 6~0°라고 가정하고 인너리도가 배명할 수 있는 한번의 길이를 L이라고 하면, 인너리도 쪽이 0.125mg이고, L값이 5mg인 경우 한번에 점용할 수 있는 인너리도의 수는 24개인대 반하여 마음도 형태의 대 "60°의 내각을 갖는 때도의 수는 26개까지 수용할 수 있는 장점이 있는 것이다.

다음의 표 2는 마음모 형태의 리드 프레임 패트 내각(a')에 따라 한번(L')에 수용함 수 있는 민너리드의 수를 나타내고 있다. [첨부그림 4]

10-0273981

[42]

병원 : ##

4 党派	L	l'(l.=5)	N.
541"	J.1425L	5.712	2784
60 *	1.04786	5.375	Seki
76 °	1.03161.	5.158	25£3
en *	1.0077L	5.038	2484

이때, 상기와 같은 표 1을 만족시키기 위한 조건증 N'는 한번에서 수용할 수 있는 언더리도의 수를 나타내는 것으로 (L'-리도족)/언더리도 마치에 해당되는 값으로 되며, 여기서 L'--^{7 2}/610g × L로 된다. 그러나, 상기와 같은 데이타는 8년에 라고 가정한 상태에서 미론적인 값이며, 실점적으로는 이 보다 더 많은 언더리도를 삽입할 수 있다.

성기와 이 발경을 기본의 정사각형 또는 적사각형 형태의 첩 및 리드 프레임 퍼드 형상을 마름모 형태의 칭으로 구성시킨과 등시에 리드 프레임 퍼드도 마용모 형태를 취합으로써 정사각형 또는 작사각현과 등일 한 면적의 반도체 침에서 그 첩 팬드의 수흥 될 수 있고, 이와 동알하게 리드 프레임의 언너라도 펴떤 을 보다 다양하게 구성시킬 수 있을 뿐만아니라 안너라도수ሼ 함말 수 있는 효과가 있다.

(57) 2174 1191

청구함 1

정사각형 형태의 반도체 리드 프레임과 이 반도체 리드 프레임과 동일한 내각을 갖는 동일한 형태의 반도 체 참과, 상기 반도체 협상에 배열 형성된 다수게의 합 패드와, 상기 다수개의 참 패드와 와이며 본당되 는 다수개의 인너리드를 구비하는 반도체 장치용 패키지혜 있어서; 상기 반도체 리드 프레임은 마름모 형 터의 다이페드로 형성되어 배치되고, 상기 반도체 리드 프레임상에 동일한 내각을 갖는 마롱모형태의 반 단체 힘이 실장되며, 상기 반도체 협의 패드상에 반도체 리드 프레임의 내각만을 들어난 다수개의 참 패 드와 이와 대용되어 형성된 다수개의 인너리드가 와이어 본당되어 형성되는 반도체 장치용 패키지.

청구한 2

제1항에 있어서, 상기 따름도 형태의 반도차 라드 프레임은 그 내각이 됐⁶ 미상으로 되는 반도체 <mark>장치용</mark> 파키지

범구함 3

제1호에 있어서, 상기 마음모 형태의 반도체 리드 프레임에 실장되는 반도체 같은 그 내각이 50° 이상으로 되는 반도체 장치용 패키지.

<u>50</u>





